

PDI-35-12G-W

PIN фотодиодный модуль, 800-1650 нм, 12 ГГц, 10 мВт

ОПИСАНИЕ

Данный модуль работает в спектральном диапазоне 800 -1650 нм на частоте до 12 ГГц с оптической мощностью до 10 мВт. Модуль согласован с одномодовым волокном. Малые габаритные размеры и вес позволяют осуществлять монтаж модулей на плату без дополнительного крепления.

PDI-35-12G-W-RM – модуль с оптическим согласованием. Пространство между волокном и фотоприемником заполнено согласующим веществом.

PDI-35-12G-W-R40 – модуль с низким обратным отражением (<-40 дБ).

Применение: аппаратура ВОСПИ.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Параметр		Един.
Обратное напряжение ФД, V_r	20	В
Обратный ток ФП, I_r	12	мА
Рабочая температура, T_c	-40 ÷ +80	°C
Температура хранения, T_{stg}	-40 ÷ +85	°C

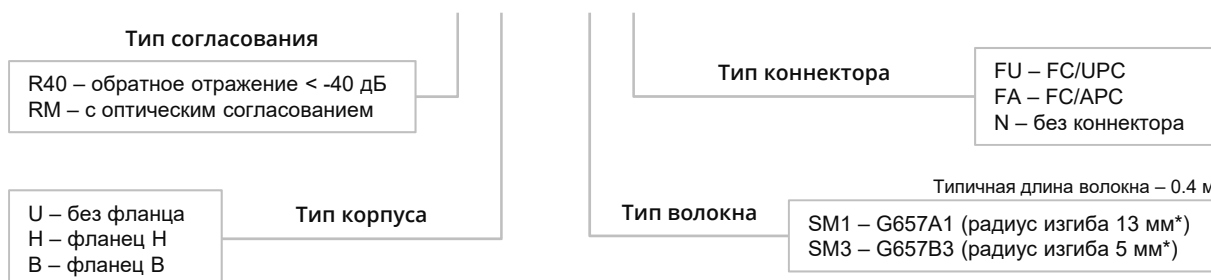
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (T = 25 °C)

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Един.	Условия
Диаметр	d	35		мкм	
Чувствительность	S_λ	0.9	0.95	A/Вт	$\lambda = 1550$ нм, $V_R = 5$ В
		0.95	1.0		
Обратное отражение*	R_L	-40		дБ	$\lambda = 1550$ нм
Темновой ток	I_d	1	1.5	нА	$V_R = 5$ В
Емкость	C_t	0.3		пФ	$V_R = 5$ В, $f = 1$ МГц
Предельная частота	f_c	12		ГГц	$\lambda = 1550$ нм, $V_R = 5$ В, $R_L = 50$ Ом, -3 дБ

* для PDI-35-12G-W-R40

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

PDI-35-12G-W-X-X-5-X-X



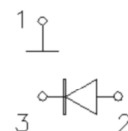
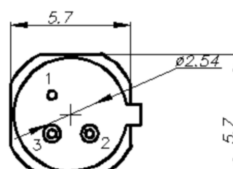
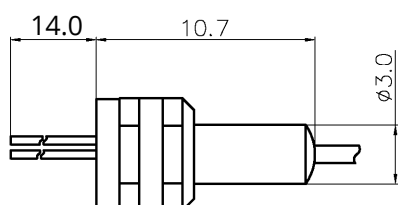
*Потери 0.1 дБ/виток при 1550 нм

Изделия сертифицированы Белорусской Торгово-Промышленной Палатой. Все компоненты, использованные в производстве, имеют сертификат ISO 9001:2008 и соответствуют директиве RoHS. Представленные данные носят информационный характер и могут быть изменены без предупреждения.

Документ обновлен 22.09.2016

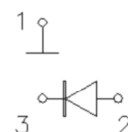
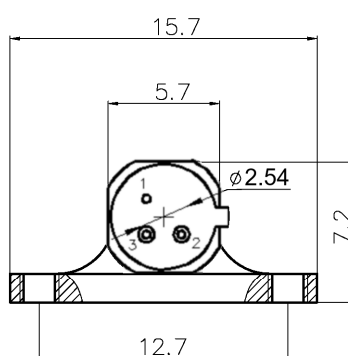
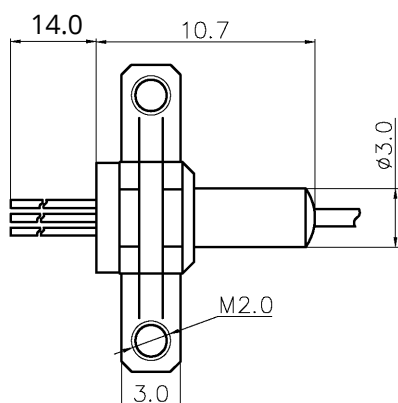
PDI-35-12G-W

U



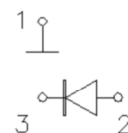
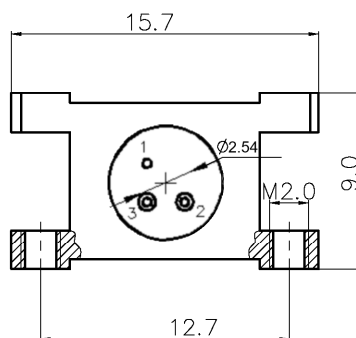
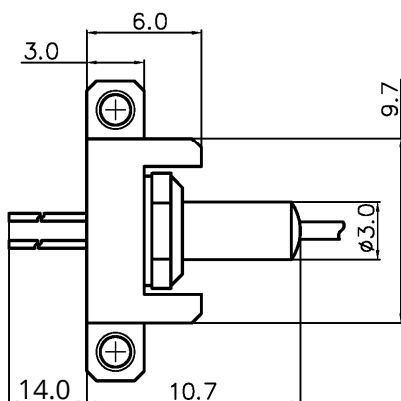
- 1. Case
- 2. Anode
- 3. Cathode

H



- 1. Case
- 2. Anode
- 3. Cathode

B



- 1. Case
- 2. Anode
- 3. Cathode

PDI-35-12G-W

SPECTRAL RESPONSE

